

分类号: TN256

单位代码: 10335

学 号: 11130021

# 浙江大学

## 博士学位论文



中文论文题目: 硅基光调制器的研究

英文论文题目: Optical Modulator

Based on Silicon-on-Insulator Platform

申请人姓名: 黄强盛

指导教师: 何赛灵

专业名称: 光通信技术

研究方向: 光通信技术

所在学院: 光电科学与工程学院

论文提交日期 2016 年 4 月 8 日



# 硅基光调制器的研究

---



论文作者签名: 签字

指导教师签名: 签字

论文评阅人 1: 丘处机 真人 登州滨都宫

评阅人 2: 葛 洪 方士 罗浮山道观

评阅人 3: 寇谦之 天师 嵩山中岳道场

评阅人 4: 张三丰 真君 武当玉虚宫

评阅人 5: 孙玄清 真人 崂山明霞洞

答辩委员会主席: 唐三藏 功佛 洛阳大慈恩寺

委员 1: 惠 能 方丈 曹溪宝林寺

委员 2: 智 顓 方丈 天台山国清寺

委员 3: 法 藏 大和尚 洛阳佛授记寺

委员 4: 道 济 和尚 临安灵隐寺

委员 5: 降 龙 尊者 天竺大雷音寺

答辩日期: 2016 年 6 月 12 日



# HVlab L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Fast Guide

## The Second Edition



Author's signature: \_\_\_\_\_

Supervisor's signature: \_\_\_\_\_

External Reviewers:	Name	Professional Title	Organization
	Name	Professional Title	Organization
	Name	Professional Title	Organization
	Name	Professional Title	Organization
	Name	Professional Title	Organization

Examining Committee Chairperson:

Name	Professional Title	Organization
------	--------------------	--------------

Examining Committee Members:


Name	Professional Title	Organization
Name	Professional Title	Organization
Name	Professional Title	Organization
Name	Professional Title	Organization
Name	Professional Title	Organization

Date of oral defence: \_\_\_\_\_ June 12th, 2016



## 浙江大学研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。


学位论文作者签名：


签字日期： 2015 年 6 月 30 日

## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解浙江大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 2015 年 6 月 30 日

签字日期： 2015 年 6 月 30 日





## 致谢

在我写这个文档的过程中，得到了网络上很多网站的帮助，在此感谢 baidu, Google, 感谢 CTeX 社区 <http://www.ctex.org>, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 学习园地: <http://blog.sina.com.cn/wangzhaoli11>, 中科大 CTAN 镜像 <http://mirrors.ustc.edu.cn/CTAN/>, 小木社区 T<sub>E</sub>X 版等网站、论坛，其他一些较小的个人网站，论坛不再一一命名，在此一并感谢。感谢浙江大学数学系提供的原始模版，感谢 88T<sub>E</sub>X 版。



## 摘要

硅基平台，即由硅衬底、二氧化硅绝缘层和硅薄膜构成的平台，不仅在传统半导体电子领域中有广泛运用，在微纳光子系统中也被广泛采用。硅基平台成为了实现微纳光电子集成芯片的理想平台。光电子集成芯片中的光通信模块，将提高芯片间的通信速度，降低通信功耗。硅基光通信模块也给传统的半导体设计和制作带来新的挑战。因此，硅基光通信模块有着巨大的研究和实用价值。光调制器做为光通信模块中不可缺少的一环，一直是该领域关注的重点。本论文的研究包含了硅基平台光调制器的两种新型方案。

第一个方案，采用混合集成技术，将直接带隙的 III-V 多量子阱材料直接键合到硅基光波导上面，利用 III-V 多量子阱材料的电吸收效应实现高速光调制器。在这种硅基混合平台上，本文设计了目前最短的双层锥形的耦合结构，实现光在纯硅波导和混合集成 III-V 波导之间的低损耗的耦合。该耦合结构长度只有  $8\ \mu\text{m}$ ，就能实现 95% 以上能量的耦合，同时拥有  $100\ \text{nm}$  的工作带宽。凭借这种双层锥形结构，本文制作和测试了硅基混合集成的 III-V 电吸收调制器。利用 III-V 材料高选择性腐蚀比的特性，我们简化了传统混合集成 III-V 波导的制作流程。并且，我们在世界上首次展示了基于能带填充效应的低驱动电压电吸收调制器。该调制器的长度有  $80\ \mu\text{m}$ ，驱动电压值只有  $50\ \text{mV}$ ，动态消光达到  $6.3\ \text{dB}$ ，与此同时调制速率有  $1.25\ \text{Gbps}$ 。这是目前世界上驱动电压最低的光调制器之一。基于能带填充效应的电吸收调制器提供了一种实现低驱动电压，低功耗，小尺寸调制器的新思路。

借助于电吸收调制器在反偏电时既是调制器也是探测器的双工作状态的特点，我们首次展示了集成两个级联的整列波导光栅，6 个高速调制器，6 个高速探测器的单片硅基混合集成的光收发模块。信道的频率间隔是  $200\ \text{GHz}$ ，单个信道的收发传输速率达到  $30\ \text{Gbps}$ 。最终在  $1.5 \times 0.25\ \text{mm}^2$  的硅基芯片，利用混合集成技术上实现了  $180\ \text{Gbps}$  的光收发模块。除此之外，我们分析比较了同个电吸收调制器在行波电极和集总电极两种工作模式下的区别。行波电极具有高速的特点，然而需要更大的驱动电压，消耗更多的功率。

第二个方案，利用硅的等离子色散效应引起的相位变化，我们设计了新型的基于可调反射镜和微环结构的光调制器。这种可调反射微环的光调制器，既有马赫-曾德尔光调制器大工作带宽的特点，也有微环调制器结构紧凑的特点。该调制器相位调制区域只有  $20\ \mu\text{m}$ ，

驱动电压只需要 2 V，调制带宽将达到 40GHz。

**关键词：** 集成光路 硅基调制器 硅基混合集成平台 电吸收调制器 光探测器 光收发模块

## **Abstract**

The quick brown fox jump over the lazy dog.

T<sub>E</sub>X

**Keywords:** T<sub>E</sub>X



# 目录

致谢 .....	I
摘要 .....	III
Abstract .....	V
目录 .....	
1 绪论 .....	1
1.1 硅基光电子集成技术的发展与现状 .....	1
1.2 硅基光调制器 .....	3
1.2.1 硅基光调制器的光学结构 .....	4
1.2.2 硅基光调制器的电极结构 .....	6
1.2.3 纯硅基光调制器 .....	8
1.2.4 硅基混合集成 III-V 光调制器 .....	8
1.2.5 硅基聚合物光调制器 .....	8
1.2.6 硅基外延锗硅光调制器 .....	8
1.2.7 硅基石墨烯光调制器 .....	8
1.2.8 硅基铌酸锂光调制器 .....	8
1.2.9 硅基钛酸钡光调制器 .....	8
1.2.10 硅基压电陶瓷光调制器 .....	8
1.2.11 硅基基于表面等离子体波导的光调制器 .....	8
1.2.12 硅基单光子调制器 .....	8
1.2.13 国内硅基光调制器的进展 .....	8
1.3 论文的内容和创新点 .....	8
1.3.1 论文内容 .....	8
1.3.2 论文创新点 .....	8
2 光器件的基本仿真方法 .....	9
2.1 波导的仿真 .....	9

2.2	器件的仿真 .....	9
2.3	系统的仿真 .....	9
2.4	多量子阱结构的仿真设计 .....	9
2.5	高速电极的仿真 .....	9
3	低驱动电压硅基电吸收调制器 .....	11
3.1	低驱动电压光调制器概述 .....	11
3.2	混合集成调制器的设计 .....	11
3.3	混合集成调制器的制作 .....	11
3.4	性能测试 .....	11
3.5	电吸收调制器的双工作模式 .....	11
3.6	硅基单片集成的光收发模块 .....	11
4	硅基反射微环的光调制器 .....	13
4.1	反射环概述 .....	13
4.1.1	可调反射率微环 .....	13
4.1.2	光栅反射微环 .....	13
4.2	可调反射率微环调制器的设计 .....	13
4.3	光栅反射微环调制器的设计 .....	13
4.3.1	光栅反射环的设计 .....	13
4.3.2	光栅反射环的制作 .....	13
4.3.3	无源性能测试 .....	13
5	高速光调制器电极的设计 .....	15
5.1	高速光调制器概述 .....	15
5.2	电极设计 .....	15
5.3	电吸收调制器不同电极的比较 .....	15
6	总结与展望 .....	17
	参考文献 .....	19
	索引 .....	21
	作者简介 .....	23
	发表文章目录 .....	25



# 1 绪论

自从进入 21 世纪，互联网已经不仅成为人类不可分割的一部分，也成为越来越多设备不可缺少的功能。人类和设备对上网带宽的需求越来越大，这促进了信息技术领域的高速发展。为了满足人类和设备日益增长的带宽需求，光通信已经从主干网逐渐渗入到了房内。而在不远的将未来，光通信将迈向最后一步进入到处理器内部。而这对光通信的器件设备提出了新的要求。

传统光器件，虽然性能满足要求，但是由于其价格高，尺寸大，功耗大将无法满足大规模的应用。因此，研究人员从各方面不断尝试新的材料，新的结构探索高速，小尺寸，低功耗，价格低廉的解决方案。目前这个研究领域依旧热火朝天的进行着。

本章首先将介绍最有希望帮助光通信迈向最后一步的硅基光电子集成技术，接着着重讨论硅基光电子器件中的硅基光调制器，介绍其目前国内外的发展现状，最后将介绍在光调制器领域内由本作者首次完成的工作。

## 1.1 硅基光电子集成技术的发展与现状

随着信息技术的发展，短距离通信的速率不断提高。当数据的通信速率达到 10 Gbps 以上时，利用金属的电互联技术将会遇到能耗，串扰，损耗和电磁干扰等问题。尤其，面对当前云计算服务器间和多核处理器内，数据的交互需要在有限的空间内同时满足大带宽、低能耗和低成本的困境时，电互联的瓶颈凸显出来。电互联的这些缺点，可以通过光通信技术来解决。然而传统光通信由于单个光器件的成本高，集成度低，阻碍了传统光通信技术在短距离通信中的应用。

硅基平台 (Silicon-On-Insulator)，即由硅衬底、二氧化硅绝缘层和硅薄膜构成的平台，不仅在传统半导体电子领域中有广泛运用，在微纳光子系统中也被广泛采用。硅基平台也成为了实现光电子集成芯片的理想平台。虽然，过去基于 III-V 材料的 InP 平台光电子平台已经实现了复杂的通信系统<sup>[2]</sup>，比如片上波分复用的光收发器和多波长路由器，但是大规模应用需要价格低廉。除此之外，InP 平台上的波导，垂直方向折射率差小只有 1%，导致波

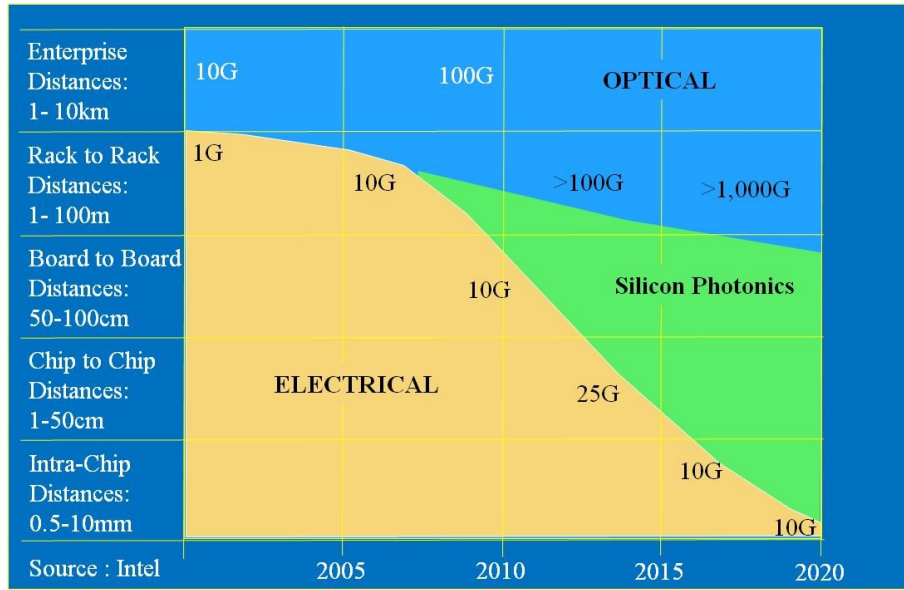


图 1-1 在不同通信距离下，电互联、硅基光通信和光纤通信的速率使用范围<sup>[1]</sup>

导的宽度和高度尺寸在工作波长量级。而硅基光波导在水平和高度方向都有将近 60% 的高折射率差，因此光波导尺寸小。又因为硅基平台晶片的单位面积成本比 InP 晶片低，尺寸又比 InP 晶片大，所以硅基平台单个光器件的成本远小于 InP 平台。此外，硅基平台的小尺寸波导传输损耗最低达到 0.4 dB/cm<sup>[3]</sup> 小于 InP 波导的最低传输损耗约为 1 dB/cm<sup>[2]</sup>。从而，硅基光电子平台越来越在光通信领域受到人们的关注。

硅基光通信模块作为硅基光电子集成芯片的一个重要应用方向，其具有带宽大，功耗低，成本低的特点。图 1-1 描述了电互联、硅基光通信和传统光纤通信和在不同距离下的适用速率范围<sup>[1]</sup>。图 1-1 也预测了随着通信速率的逐年提高，硅基光通信在短距离将逐渐代替电互联。因此，硅基光集成芯片越来越受到各国的关注。美国在 2004 年率先提出了 EPIC (Electronic and Photonic Integrated Circuits on Si) 计划，研究硅基光电子集成平台，这将有助于通信，传感，微波光子学等研究方向的发展<sup>[4]</sup>。欧洲在 2008 年提出了 HELIOS (pHotonics ELectionics functional Integration on CMOS) 计划，研究基于 CMOS 工艺的硅基光电子平台<sup>[5]</sup>。日本也紧跟而上，在 2010 年提出了 PECST (Photonics and Electronics Convergence System Technology)，推动硅基光电子平台的发展，实现芯片间的通信带宽密度达到 10 Tb/s/cm<sup>2</sup><sup>[6]</sup>。

光集成芯片的概念最早是由美国贝尔实验室的 Miller 在 1969 年提出来的<sup>[7]</sup>。随后 1993，美国空军科学研究实验室的 Richard A. Soref 提出了的硅基光电子集成芯片的概念<sup>[8]</sup>，见图 1-2 (a)。硅基光电子芯片是在同一片硅衬底上集成了负责逻辑和驱动的晶体管，负责光通信的激光器，调制器，光放大器，光探测器，光无源结构，光波导和光纤的耦合结构。在接下来的 20 多年内，全世界的知名高校和半导体公司都投入大量资金到这个领域中。在 2011 年，见图 1-2 (b)，Intel 厚积薄发推出了世界上第一款硅基光通信芯片包含了片上的激光器，

纯硅调制器和硅锗探测器的光通信模块，实现了单通道 12.5 Gbps 的传输速率<sup>[9]</sup>。在 2012 年，见图 1-2 (c, d)，IBM 紧接发布了利用改进的 90 nm CMOS 工艺线，实现了在单个硅片上同时集成晶体管和的 25 Gbps 的光调制器和探测器<sup>[10]</sup>。Intel 虽然集成了激光器但是没能在单片上同时集成晶体管，而 IBM 虽然集成了晶体管，却没能集成激光器并且缺少完整光收发链路的展示。在 2015 年，美国伯克利大学和麻省理工大学的 Chen Sun 等首次展示了直接在商业化的 45 nm CMOS 流水线上，制作硅基光电子集成芯片<sup>[11]</sup>。该单块芯片，见图 1-3 (a)，上不仅包含处理器，内存，还包含光收发模块。并且他们还展示了如图 1-3 (b) 所示的处理器芯片和内存的芯片直接用光互联技术进行时时数据的运算和处理。虽然该硅基光电子芯片依旧缺少片上的激光器和放大器，但是该芯片是目前最复杂的单片硅基光电子芯片，包含了 700 万个晶体管和 850 个光模块。

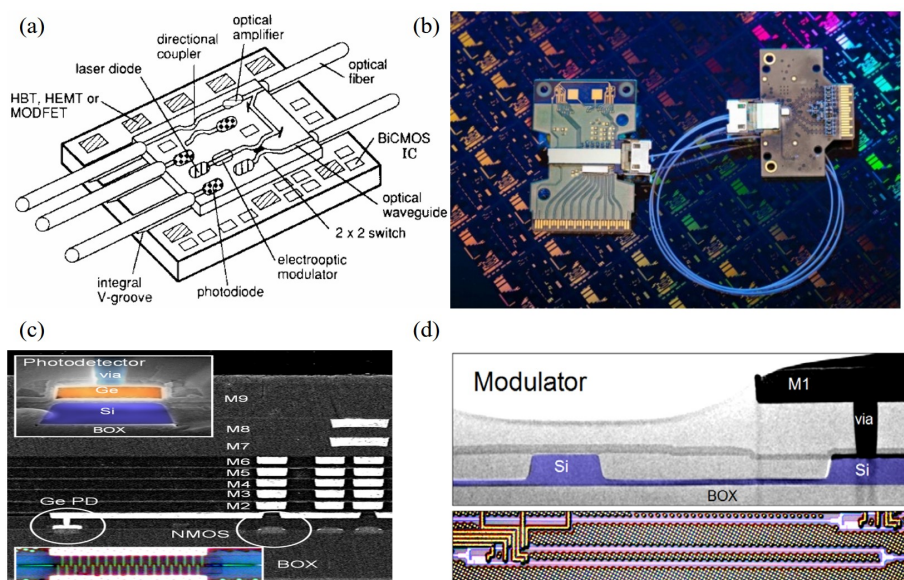


图 1-2 (a) 最早的硅基光电子芯片概念图<sup>[8]</sup>；(b) Intel 的硅基光收发模块<sup>[9]</sup>；(c, d) IBM 的硅基探测器和调制器<sup>[10]</sup>

## 1.2 硅基光调制器

硅基光调制器做为硅基光通信模块中不可缺少的一环，连接了电信号向光信号的转化，影响着光通信模块的通信速度和能耗，一直硅基光通信领域的重点和难点。下面将讨论目前硅基光调制器在光学结构和电学结构的研究成果，概括不同材料在硅基平台上实现光调制器的最新进展。

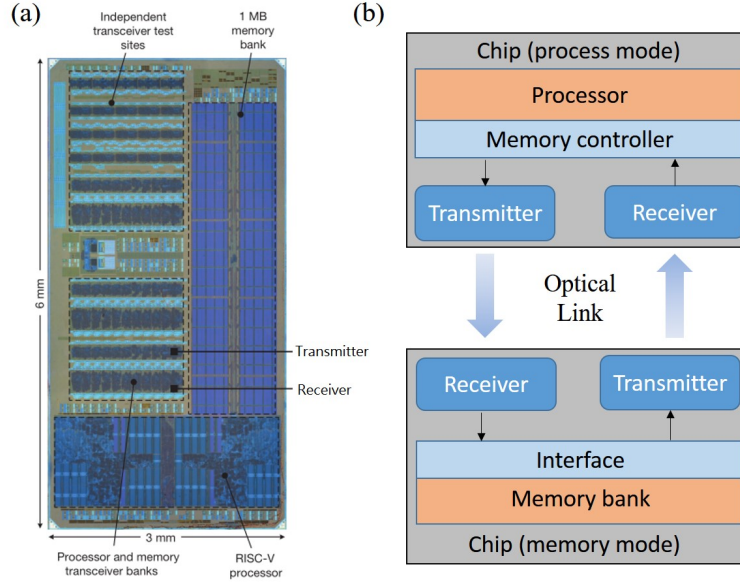


图 1-3 (a) 单片硅基光电子芯片，包含处理器，内存，光收发模块<sup>[11]</sup>；(b) 处理器芯片和内存芯片间光互联示意图

### 1.2.1 硅基光调制器的光学结构

硅基光调制器如同传统的光调制器，是利用电信号改变材料折射率的实部或者虚部，从而调制器光信号的相位或者幅度。材料的折射率可以用可以表示为：

$$\widetilde{n(\lambda)} = n(\lambda) + j\kappa(\lambda) = n(\lambda) + j\frac{\lambda\alpha(\lambda)}{2\pi} \quad (1-1)$$

其中  $n$  为材料折射率的实部， $\kappa$  为材料折射率的虚部 (称作消光系数)。 $\alpha$  是材料单位长度的损耗。 $n, \kappa, \alpha$  都是和波长相关。其中  $\kappa$  和  $\alpha$  是线性关系。 $n$  和  $\kappa$  可以用通过 Kramers-Kronig 联系到一起。

图 1-4 概括了硅基光调制器的光学结构的四大类型。前两类都是利用电光效应改变光的相位，再利用光学结构转化为光强度的变化。后两类是利用电吸收效应直接改变光的强度。

第一类如图 1-4 (a) 所示，通过调制折射率实部，改变谐振波长的位置，实现特定波长的调制。这类调制器的特点是结构紧凑，速度快，驱动电压小，能耗低。图 1-5 (a) 展示了最早利用这种结构实现的硅基光调制器的实例<sup>[12]</sup>。该调制器利用载流子注入效应，调制硅波导的折射率，移动微环的谐振峰，从而实现谐振波长处光强的调制。

第二类如图 1-4 (b) 所示，也是通过调制折射率实部，实现相位的调制。这类调制器但是利用马赫曾德结构，将一根波导上的相位变化，转变成强度调制器。其特点是速度快，光学带宽大。图 1-5 (b) 展示了最早利用这种结构的硅基光调制器实例<sup>[13]</sup>。该调制器也是利用载流子注入效应，实现马赫曾德一臂的相位变化，从而调制输出的光强。



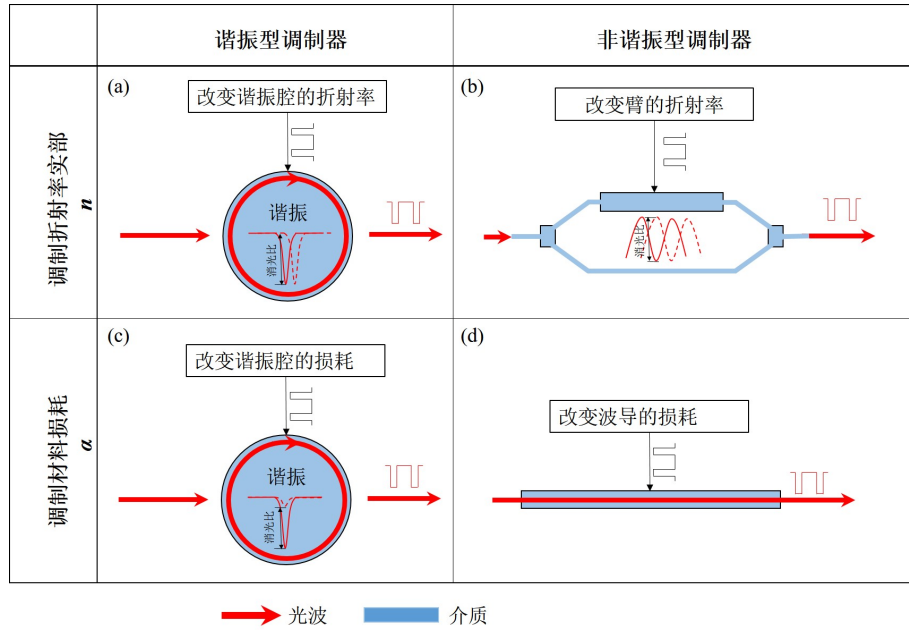


图 1-4 (a, b) 分别是通过调制折射率实部的谐振和非谐振型光调制器；(c, d) 分别是通过调制材料损耗的谐振和非谐振型光调制

第三类如图 1-4 (c) 所示，通过调制微环的损耗，从而影响微环的谐振波长处的临界耦合系数，从而调制谐振波长的强度。这类调制器的特点是结构紧凑，驱动电压低，能耗低，速度快。图 1-5 (c) 展示了最早利用这种结构的硅基光调制器的实施方案<sup>[14]</sup>。该调制器利用微环中部分硅波导上的石墨烯，调制石墨烯的损耗，导致微环损耗的变化，从而调制谐振波长处光的强度。由于这类调制器是最近 2012 年才提出的，目前只在氮化硅平台上有实例<sup>[15]</sup>，在硅基平台上没有实例，只有理论分析的结果<sup>[14]</sup>。

第四类如图 1-4 (d) 所示，直接通过改变波导的损耗，实现光强度的调制。这类调制器的特点是结构紧凑，能耗低，速度快，光学带宽大。图 1-5 (d) 展示了利用这种结构的硅基光调制器实例<sup>[16]</sup>。该调制器是将 InP 混合集成到硅波导上，再利用 InP 多量子阱材料 (Multiple Quantum Well, MQW) 中量子束缚 Stark 效应 (Quantum Confined Stark Effect, QCSE) 实现在不同电压下，材料吸收峰的移动，导致波导的损耗的变化，从而实现光强度的变化。

这四类调制器中的马赫曾德结构除了能用于将光的相位变化转变成强度变化外，还经常被用于高级调制码型的发生器，比如文献 [17] 中就利用马赫曾德结构实现正交相移键控 (Quadrature Phase-Shift Keying, QPSK) 调制码形，并且结合了偏振复用，使单通道的调制速度提高到 112 Gbps。

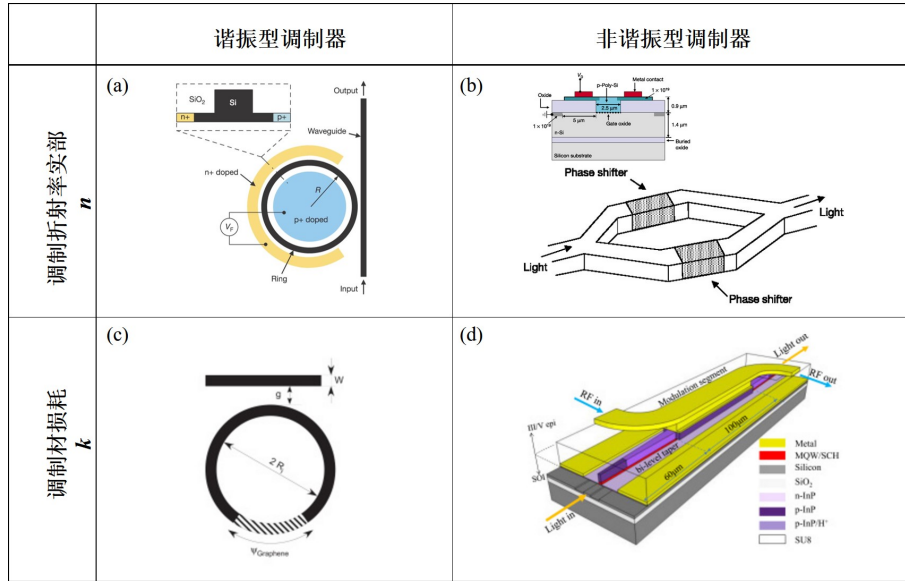


图 1-5 (a, b) 分别是通过调制折射率实部的谐振和非谐振型光调制器的实例<sup>[12,13]</sup>; (c, d) 分别是通过调制材料损耗的谐振和非谐振型光调制的实例<sup>[14,16]</sup>

### 1.2.2 硅基光调制器的电极结构

硅基光调制器的电极结构对调制速率和能耗也有很大影响。图1-6展示了目前硅基光调制器所有的四种电极结构。这四种电极结构已经在 InP 光调制器和 LiNbO<sub>3</sub> 光调制器上被广泛应用。下面将讨论这四种电极结构特点。

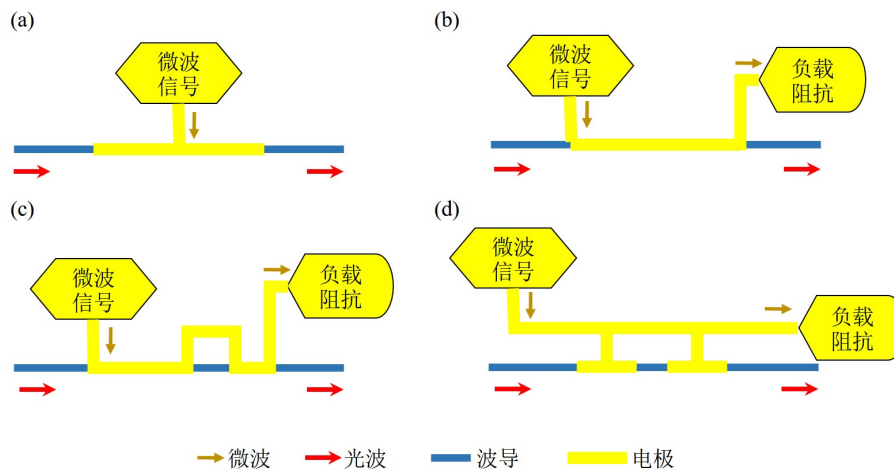


图 1-6 (a) 集总电极; (b) 行波电极; (c) 分段传输线电极; (d) 电容负载行波电极

第一种电极称为集总电极 (lumped electrode) 如图1-6 (a) 所示, 这种电极在调制区域的长度小于  $100\ \mu\text{m}$  的硅基光调制器中被广泛使用, 尤其是小型的谐振型硅基光调制器。由于这类电极末端没有负载是开路, 导致微波信号末端反射, 集总电极上成为驻波, 从而降低所需外界的调制电压, 同时也避免了偏置电压在负载上损失的能耗。因此, 集总电极在小尺寸, 低驱动电压, 低能耗的电极上有广泛的应用。图1-7 (a) 展示了集总电极用于 InP 混

合集成到硅波导上的调制器<sup>[18]</sup>，实现了低能耗，低驱动电压，小尺寸的调制器。

第二种电极称为行波电极如图1-6(b)所示，这种电极在调制区域大于  $100\ \mu\text{m}$  的硅基调制器中被广泛使用，尤其是马赫曾德的硅基光调制器。由于这行波电极调制器需要将电极考虑成为传输线，因此需要设计电极本征阻抗与标准的微波器件的本征阻抗  $50\ \Omega$  相匹配，并且使传输线的传播常数和波导中光的传播常数相匹配，从而尽可能提高调制器的调制带宽。因此，使用行波电极的调制器，在尺寸，驱动电压，能耗上多要高于集总电极的调制器，但是调制速率会有所提高。图1-7(b)展示了行波电极用于 InP 混合集成到硅波导上的调制器<sup>[18]</sup>，实现了高速的硅基光调制器。

第三种电极称为分段传输线电极 (Segmented Transmission Line Electrode) 如图1-6(c)所示，这种电极也是主要用于调制长度大于  $100\ \mu\text{m}$  以上，并且电极的本征电阻和  $50\ \Omega$  相差大，或者微波和光波的传播常数相差较大的硅基光调制器。分段传输线电极是行波电极的一个更为普遍的形式，相比行波电极，其调制带宽可以进一步提高，但是能耗不会有所减少，而尺寸将更进一步增大，。图1-7(c)展示了分段传输线电极用于 InP 混合集成到硅波导上的调制器<sup>[18]</sup>，实现了目前调制速度最快的硅基光调制器。

第四种电极称为电容负载行波电极 (Capacitively-Loaded Traveling-Wave Electrode) 如图1-6(d)所示，这种电极在硅基光调制器中的应用比较少，主要用于调制长度大于  $500\ \mu\text{m}$  以上，并且电极的本征电阻和  $50\ \Omega$  相差大，或者微波和光波的传播常数相差较大的硅基光调制器。由于电容负载行波电极整体和如同行波电极一样，但在单个周期内，调制器区域是集总电极，因此这类电极用于兼顾传输速度和低驱动电压。不过，由于在单个调制器区域还有没参与调制的电极，因此电容负载行波电极的尺寸比较大。图1-7(d)展示了电容负载行波电极用于 InP 混合集成到硅波导上的调制器<sup>[18]</sup>，实现了马赫曾德的光调制器。

这四种电极各有优缺点，如果需要尺寸小，能耗低的调制器，可以采用集总电极。如果需要尽可能高的调制速度，或者调制器区域长度比较长时则可以采用行波电极或分段传输线电极结构。而电容负载行波电极是集总电极和分段传输线折中的形式，可以在这两种电极无法满足要求的情况下使用。

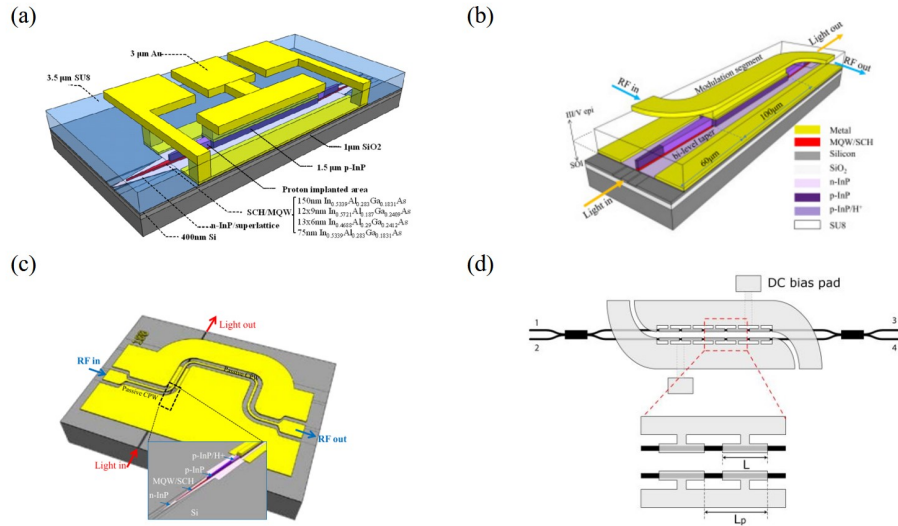


图 1-7 (a) 集总电极的实例<sup>[18]</sup>; (b) 行波电极实例<sup>[16]</sup>; (c) 分段传输线电极实例<sup>[19]</sup>; (d) 电容负载行波电极实例<sup>[20]</sup>

### 1.2.3 纯硅基光调制器

### 1.2.4 硅基混合集成 III-V 光调制器

### 1.2.5 硅基聚合物光调制器

### 1.2.6 硅基外延锗硅光调制器

### 1.2.7 硅基石墨烯光调制器

### 1.2.8 硅基铌酸锂光调制器

### 1.2.9 硅基钛酸钡光调制器

### 1.2.10 硅基压电陶瓷光调制器

### 1.2.11 硅基基于表面等离子体波导的光调制器

### 1.2.12 硅基单光子调制器

### 1.2.13 国内硅基光调制器的进展

## 1.3 论文的内容和创新点

### 1.3.1 论文内容

### 1.3.2 论文创新点



## 2 光器件的基本仿真方法

### 2.1 波导的仿真

### 2.2 器件的仿真

### 2.3 系统的仿真

### 2.4 多量子阱结构的仿真设计

### 2.5 高速电极的仿真



### **3 低驱动电压硅基电吸收调制器**

本章概述了低驱动电压光调制器，详细介绍了低驱动电压电吸收调制器的理论原理和公式。最后阐述了利用电吸收调制器的双工作模式实现单片多波长复用的光收发模块。

#### **3.1 低驱动电压光调制器概述**

#### **3.2 混合集成调制器的设计**

#### **3.3 混合集成调制器的制作**

#### **3.4 性能测试**

#### **3.5 电吸收调制器的双工作模式**

#### **3.6 硅基单片集成的光收发模块**



## 4 硅基反射微环的光调制器

### 4.1 反射环概述

#### 4.1.1 可调反射率微环

#### 4.1.2 光栅反射微环

### 4.2 可调反射率微环调制器的设计

### 4.3 光栅反射微环调制器的设计

#### 4.3.1 光栅反射环的设计

#### 4.3.2 光栅反射环的制作

#### 4.3.3 无源性能测试



## 5 高速光调制器电极的设计

### 5.1 高速光调制器概述

### 5.2 电极设计

### 5.3 电吸收调制器不同电极的比较





## 6 总结与展望



## 参考文献

- [1] M. Zuffada. The industrialization of the silicon photonics: Technology road map and applications[C]//Solid-State Device Research Conference (ESSDERC), 2012 Proceedings of the European. Sept 2012:7–13.
- [2] Meint Smit, Xaveer Leijtens, Huub Ambrosius, et al. An introduction to inp-based generic integration technology[J]. Semiconductor Science and Technology, 2014. 29(8):083001.
- [3] Tsuyoshi Horikawa, Daisuke Shimura, Tohru Mogami. Low-loss silicon wire waveguides for optical integrated circuits[J]. MRS Communications, 2016. FirstView:1–7.
- [4] J. Shah. DARPA'S EPIC program: electronic and photonic integrated circuits on Si[C]//Group IV Photonics, 2005. 2nd IEEE International Conference on. Sept 2005:1–3.
- [5] HELIOS project. <http://www.helios-project.eu/>.
- [6] Y. Arakawa, T. Nakamura, Y. Urino, T. Fujita. Silicon photonics for next generation system integration platform[J]. Communications Magazine, IEEE, March 2013. 51(3):72–77.
- [7] Stewart E Miller. Integrated optics: an introduction[J]. Bell System Technical Journal, 1969. 48(7):2059–2069.
- [8] Richard A. Soref. Silicon-based optoelectronics[J]. Proceedings of the IEEE, Dec 1993. 81(12):1687–1706. doi:10.1109/5.248958.
- [9] Mario J. Paniccia. A perfect marriage: optics and silicon[J]. Optik & Photonik, 2011. 6(2):34–38.
- [10] S. Assefa, S. Shank, W. Green, et al. A 90nm cmos integrated nano-photonics technology for 25gbps wdm optical communications applications[C]//Electron Devices Meeting (IEDM), 2012 IEEE International. Dec 2012:33.8.1–33.8.3.
- [11] Chen Sun, Mark T Wade, Yunsup Lee, et al. Single-chip microprocessor that communicates directly using light[J]. Nature, 2015. 528(7583):534–538.
- [12] Qianfan Xu, Bradley Schmidt, Sameer Pradhan, Michal Lipson. Micrometre-scale silicon electro-optic modulator[J]. nature, 2005. 435(7040):325–327.
- [13] Ansheng Liu, Richard Jones, Ling Liao, et al. A high-speed silicon optical modulator based on a metal–oxide–semiconductor capacitor[J]. Nature, 2004. 427(6975):615–618.
- [14] Michele Midrio, Stefano Boscolo, Michele Moresco, et al. Graphene–assisted critically–coupled optical ring modulator[J]. Opt. Express, Oct 2012. 20(21):23144–23155.

- [15] Christopher T Phare, Yoon-Ho Daniel Lee, Jaime Cardenas, Michal Lipson. Graphene electro-optic modulator with 30 ghz bandwidth[J]. Nature Photonics, 2015. 9(8):511–514.
- [16] Yongbo Tang, Hui-Wen Chen, Siddharth Jain, et al. 50 gb/s hybrid silicon traveling-wave electroabsorption modulator[J]. Optics express, 2011. 19(7):5811–5816.
- [17] Po Dong, Chongjin Xie, Long Chen, et al. 112-gb/s monolithic pdm-qpsk modulator in silicon[J]. Opt. Express, Dec 2012. 20(26):B624–B629.
- [18] Yongbo Tang, Jonathan Peters, John E Bowers. Energy efficient hybrid silicon electroabsorption modulator for 40 gb/s, 1-volt uncooled operation[J]. IEEE Photonics Technololy Letters, 2012. 24(19).
- [19] Yongbo Tang, Jonathan D Peters, John E Bowers. Over 67 ghz bandwidth hybrid silicon electroabsorption modulator with asymmetric segmented electrode for 1.3  $\mu\text{m}$  transmission[J]. Optics express, 2012. 20(10):11529–11535.
- [20] Hui-Wen Chen, Jonathan D Peters, John E Bowers. Forty gb/s hybrid silicon mach-zehnder modulator with low chirp[J]. Optics express, 2011. 19(2):1455–1460.

## 索引

$\text{T}_\text{E}\text{X}$ , [V](#)



## 作者简历

1. 第一条的内容
2. 第二条内容





## 发表文章目录

1. 第一篇
2. 第二篇